## 科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 30 年 6 月 1 3 日現在

機関番号: 82626
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2016~2017
課題番号: 16K18097
研究課題名(和文)Research on monolithically integrated autocorrelator using PIN-type silicon waveguide
研究課題名(英文)Research on monolithically integrated autocorrelator using PIN-type silicon waveguide
研究代表者
Cong Guangwei(Cong, Guangwei)
国立研究開発法人産業技術総合研究所・電子光技術研究部門・主任研究員
研究老委里,20470040
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、シリコンPIN導波路を二光子吸収型光パルス検出器として干渉型オートコリレーターを実現し、1ピコ秒光パルスに対して正確なパルス幅計測に成功した。従来な製品に使用される 非線形結晶と光電増倍管に比べてほぼ同様な高感度を実現し、従来なバルク二光子吸収型検出器に比べて約 100倍の超高感度が得られた。さらに、非線形効果を含めて開発したシミュレータで計測の正確度やパルスパ ワーの依存性等の実験結果を理論的に解明した。最終に、集積型オートコリレーターの動作も確認した。本研究 はオートコリレーターの小型化、低コスト化のような革新をもたらすこととオンチップ光信号計測等への幅広い 応用とも期待されている。

研究成果の概要(英文):In this study, the interferometric autocorrelation was achieved by utilizing the silicon p-i-n waveguide as the two-photon absorption optical pulse detector and correct pulse characterization was successfully demonstrated for 1-ps optical pulses. We also achieved a very high sensitivity which is almost same as that of conventional autocorrelators using nonlinear optical crystals and photomultiplier, nearly 100 times higher than that of traditional two-photon absorption type detectors. Moreover, we developed an autocorrelation simulator with nonlinear effects included, based on which the experimental results such as the pulse power dependent photocurrent and measurement accuracy were reasonably explained. Finally, we fabricated the monolithically integrated autocorrelator and confirmed its operation for sub-ps pulses. This work promises innovations of unprecedented compactness and low cost for autocorrelator products and is also expected to be applied to on-chip pulse characterization.

研究分野:工学

キーワード:オートコリレーター 超短光パルス シリコンフォトニクス フォトニクス集積回路 導波路 二光子 吸収

## 1.研究開始当初の背景

(1) ピコ秒またはそれ以下の超短光パルス は超高速光信号処理システム、超高速光計測、 バイオイメージングための超高速レーザー 顕微鏡等の幅広い領域に応用されている。そ こでは光パルスを時間領域でできるだけ正 確に計測することが必要である。このような 超短光パルスの波形を直接に計測すること は通常困難であるため、よく用いられている 手法は自己相関を利用するオートコリレー ターと呼ばれる計測器でパルス波形を評価 する。従来のオートコリレーター製品には、 自由空間光学コンポーネント、および検出器 として使用される非線形結晶と光電増倍管 の組み合わせによる構成されており、大型で 高価、第二高調波を発生するように位相整合 を調整も困難である。近年ではシステム小型 化、低コスト化を求めるため、導波路型パル ス検出器あるいは集積フォトニクス技術を 基に集積オートコリレーターを目指す研究 が進みつつある(引用文献 ~ J (2)また、応用としては、生体材料計測や オンチップ信号計測等のより低パワーのパ ルスの測定が重要となっている。そのために 集積型パルス検出器を高感度化することが 要求されている。本研究では、産総研SCR において性能が優れるシリコンPIN導波 路を開発することで、この導波路の強い光閉 じ込めにより増強された二光子吸収効果を 利用して、高感度導波路型パルス検出器また はこの検出器を用いた集積型オートコリレ ーターを実現することを目指している。本研 究はオートコリレーターの小型化、低コスト 化のような革新をもたらすこととオンチッ プ光信号処理や計測等への幅広い応用とも 期待されている。

2.研究の目的

(1)サブミクロメーター幅のシリコン PIN 導波路により増強された二光子吸収を用い て、この導波路を超短光パルス検出器として 高感度なオートコリレーター動作を実証し することを目指している。さらに、シリコン フォトニクス技術を基づいた集積型オート コリレーターの動作を確認する。 (2)実応用のため測定条件(入力パルス幅 の制限、入力パワーの影響、測定正確度等) を説明し、その物理的な要因を解明する。

3.研究の方法

(1)デバイスシミュレータ(Lumerical) でPIN導波路を設計し、二光子吸収が増強さ れたことを理論的に確認する。

(2) 産総研 SCR シリコンフォトニクスプラットフォームを利用してトップシリコン厚220mmのSOIウエハでデバイス試作を行う。
 また、操作性に優れる光ファイバベースの測

定系を立ち上げ、超短光パルスの波形を自動 的に測定、デバイスの特性評価をする。 (3)非線形効果(二光子吸収効果、自由キ ャリアプラズマ効果等)を含めた FDTD 法に よる超短光パルスの自己相関シミュレータ を開発する。このシミュレータでの得られた 結論を実験で検証する。

4.研究成果

(1) **ここに記載された成果は論文(**0pt. Express、Vol. 24、 Issue 26、2016、 pp.29452-29458) で発表された。図1(a) で示す PIN リブ導波路を設計し、Lumerical シミュレータでこの導波路のモードを計算 した。図1(b)で示すようなTEモードの プロファイルを使用して導波路の有効面積 を計算した結果、約0.1µm<sup>2</sup>であり、光を強く 光閉じ込めることができる。この面積を用い て、二光子吸収に誘導された光電流を計算し、 さらに従来の厚いリブ導波路(文献)に対 比したところでより約66倍の光電流が予想 された(図2)。この増強された二光子吸収 を利用し、高感度パルス検出器が期待される。





(2) ここに記載された成果は会議論文 (ECOC2017、P1.SC2.21)で報告された。産 総研 SCR の 3 0 0 mm ラインのシリコンフォト ニュースプラットフォームを利用して 220nm 厚のシリコンおよび3ミクロン厚の埋め込み 酸化膜を備えたシリコンフォトニクス SOI 基 板にデバイスを制作した。製作した位相シフ タ長が1mmのデバイスの光学顕微鏡図を 図3に示す。<br />
光入出力は赤矢印で表示され、 自己相関をしているパルスを入力すると二 つパルスの時間遅延に対して p と n コンタク トの間に流れる光電流を測定によるパルス の波形を計測することができる。このデバイ スには、約430nm幅のチャンネル導波路を 接続導波路とし、500nm幅と110nmスラブ 厚を有する PIN 導波路に接続する。その接続 部(拡大図で示す)にはロスが非常に低い構 造を使っている。



図3.製作したデバイスの顕微鏡図とオートコリ レーター動作の原理図



図4.オートコリレーター測定システムの構成(a) と原理図(b)

上に述べた PIN 導波路デバイスで超短光 パルスのオートコリレーターの動作を検証 するため、図4で示している測定系を構築し た。ファイバレーザー(FL)から出た光パル ス(約1ピコ幅)を分岐させて二つの高精度 可変遅延線(TDL)をそれぞれに通じて結合 してから PIN 導波路のチップに入れる。図4 (b)で示すように自己相関をしているパル スの時間差をチューニングする、同時に、電 流電圧ソースメーター(SM)でPINダイオー ドに逆10V バイアスを印加して二光子吸収 に起こった光電流を測定する。入力パルスの ピークパワーが1.22ワットと0.04ワットの 場合(1ピコ秒幅である場合にはパルスエネ ルギは1.22pJと0.04pJとなる)で測定し たオートコリレーターの光電流を図5に示 す。測定された相関幅に対し、パルス形状が sech<sup>2</sup>形と仮定して、パルス幅(=相関幅/1.54) はほぼ1ピコ秒であり、商用オートコリレー ターで測定結果に一致した。したがって、 のPIN導波路を用いて干渉型オートコリ レーター動作を実証し、1 ビコ秒光パルスに 対して正確なパルス幅計測に成功した。感度 を評価するため、パルスパワーを減らして同 様に測定を行い、1mmデバイスで1×10-8 №2 レベルの非常に高い感度が得られた。この PIN 導波路検出器は、**従来な自由空間光学で** 組立したオートコリレーター製品に使用さ れる非線形光学結晶と光電増倍管の組み合 わせ構成に比べてほぼ同等な高感度を持ち、 従来なバルク二光子吸収型検出器に比べて 約100倍の<br />
感度であった。<br />
この成果は光通 信技術に関する世界的国際会議の一つであ る ECOC2017 にて報告された。

さらに、最終年度には集積型オートコリ レーターの設計と試作を行い、サブピコ秒 (0.1~0.4 ピコ秒)の光パルスに対し、オー トコリレーターの動作もできることが確認 され。現在、このデバイスの詳細測定が進め られている。



図5.測定したオートコリレーターの光電流の波形。パルスエネルギは(a)1.22 と(b)0.04 pJ。

(3) ここに記載された成果は論文(Opt. Express、Vol. 26、 Issue 12、2018、 pp.15090-15100.)で発表された。PIN 導波路 を超短パルス検出器とする特性を解明する のは非線形効果(二光子吸収効果、自由キャ リアプラズマ効果等)を考えることが必要。 そのため、そのような非線形効果を含めた FDTD 法に基づいた超短光パルスの自己相関 シミュレータを開発した。シミュレーション 結果は実験結果とよく一致することができ、 実験結果の物理的な要因を解明した。具体的 には下記のような3点である。

(i) 1.22pJ のパルスエネルギで測定した自 己相関の波形はノイズを含めてシミュレー タした波形に良く再現された(図6), 1.22pJ はファイバ中のパルスエネルギであり、ファ イバとチップの結合損を含めた PIN 導波路の 入力端までのロスを 4.2 dB を考えると、真 の入力エネルギは 0.5pJ になる。そこで、シ ミュレーションは 0.5pJ で実行した。

(ii)図6に示されるように実験で得られた 光電流値はシミュレーションとほぼ一致し た。また、光電流値のパルスパワーの依存性 も計算した結果を図7(a)に示す。シミュ レーションには二つ二光子吸収係数(0.9 と 4.5 cm/GW)を用いた。その理由は論文(Opt. Express、Vol. 26、 Issue 12、2018、 pp.15090-15100.)で説明している。サブpJ 以下の領域では、光電流がパルスエネルギに 対して二乗の依存があり、これは二光子吸収 に誘導された光電流の特徴である。高いパル スエネルギにおいて光電流値は二乗の依存 からずれるのは、自由キャリア吸収効果が現 れることが原因である。



図6.測定した光電流の波形とシミュレートされ た波形の比較。

**(iii)**図7(b)に、測定したパルス幅の パルスエネルギの依存性を示す。サブワット 以下の低いピークパワー領域では正確なオ ートコリレーター計測に成功した。なお、パ ルスピークパワーが1W(1pJの1psのパル スパワー)を超えると計測エラーも増やして いる。エラーが増えはじめるパワーの閾値は デバイスの長さを短くすると高くなる。導波 路の中に伝搬されているパルスの形を調べ たところで、二光子吸収過程で発生した自由 キャリアによる屈折率の変化と吸収の時間 域での非対称性を原因であることが解明さ れた。したがって、オンチップや生体材料計 測などの弱いパルスに応用される場合には 正確なパルス計測ができ、強いパルスを測定 する場合には減衰器でパワーをへらしてか ら測定すると考えている。

最後にその導波路型パルス検出器の使 えるパルス幅の制限を重要な特性の一つと して検討した。導波路の群速度分散(GVD) であるため、より短いパルス幅が広くなる。 最小の応用できるパルス幅はGVDに決めるこ とを考えて、GVDにより生じるパルス幅の変 化を図8に示す。従来のオートコリレーター 製品に使っている非線形結晶LiIO3に対比し て、長0.1mmのPIN導波路はLiIO3とぼほ 同様な特性を持ち、数十フェムト秒までも測 定が可能。長1mmの場合には約0.13ピコ秒 以上のパルスを正確に計測できる。したがっ て、このデバイスはピコ秒またはサブピコ秒 のパルスに応用することができる。



図7.(a) 光電流のパルスエネルギの依存性。(b) 計測されたパルス幅のパルスエネルギの依存性。



<sup>&</sup>lt;引用文献>

C. Monat, C. Grillet, M. Collins, A. Clark, J. Schroeder, C. Xiong, J. Li, L. O'Faolain, T.F. Krauss, B. J. Eggleton, D. J. Moss, Integrated optical auto-correlator based on third-harmonic generation in a

silicon photonic crystal waveguide, Nature Communications 5, 2014, 3246, T.K. Liang, H.K. Tsang, I.E. Day, J. Drake, A.P. Knights, M. Asghari, Silicon waveguide two-photon absorption detector at 1.5 µm wavelength for autocorrelation measurements, Appl. Phys. Lett 81(7), 2003, 1323-1325, R. Havakawa, N. Ishikura, H.C. Nguyen, "Two-photon-absorption Τ. Baba. photodiodes in Si photonic-crystal slow-light waveguides, Appl. Phys. Lett. 102(3), 2013, 031114. Κ. Kondo 、 T. Baba 、 On-chip autocorrelator using counter-propagating slow light in a photonic crystal with two-photon absorption photodiodes, Optica 4 (9), 2017、1109-1112。 5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線) [ 雑誌論文] ( 計 2 件 ) Guangwei Cong, Morifumi Ohno, Yuriko Maegami, Makoto Okano, Koji Yamada, Optical autocorrelation performance of silicon wire p-i-n waveguides utilizing the enhanced two-photon absorption、**Opt. Express、**查読有、Vol. 24、 Issue 26、 2016、 pp.29452-29458. https://doi.org/10.1364/0E.24.029452 Guangwei Cong, Makoto Okano, Yuriko Maegami, Morifumi Ohno, Koji Yamada, Interferometric autocorrelation of ultrafast optical pulses in silicon sub-micrometer p-i-n waveguides, Opt. Express、查読有、Vol. 26、 Issue 12、 2018, pp.15090-15100. https://doi.org/10.1364/0E.26.015090 [学会発表](計3件) G. W. Cong, M. Ohno, Y. Maegami, M. Okano, K. Yamada, Autocorrelation Operation using Enhanced Two-photon Absorption Induced Photocurrent in Sub-micrometer Silicon PIN Waveguide、 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), C-1-05、2016. Guangwei Cong, Morifumi Ohno, Yuriko Maegami, Makoto Okano, Koji Yamada, Autocorrelation measurement of ultrafast optical pulses using silicon waveguides as two-photon p-i-n absorption detector、第78回応用物理 **学会**秋季学術講演会 6p-A414-16、2017. Guangwei Cong 、Yuriko Maegami 、

Makoto Okano, Morifumi Ohno、 Koii Yamada High-sensitivity Autocorrelation Measurement ٥f Ultrafast Optical Pulses Using Silicon Wire P-I-N Waveguides, 43rd European Conference on Optical Communication (ECOC), P1.SC2.21, 2017. 〔図書〕(計 0件) 〔産業財産権〕 出願状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: 取得状況(計 0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: [その他] ホームページ等 6.研究組織 (1)研究代表者 Cong Guangwei 国立研究開発法人産業技術総合研究所・エ レクトロニクス・製造領域・主任研究員 研究者番号: 20470049 (2)研究分担者 ( ) 研究者番号: (3)連携研究者 ( ) 研究者番号: (4)研究協力者 山田 浩治 (Yamada, Koji) 大野 守史(Ohno, Morifumi)